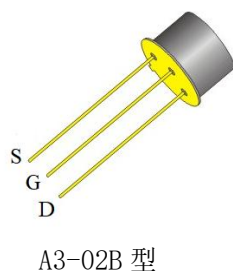


LYNM210G 大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1、特性

LYNM210G 型大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管具有开关速度快、损耗小、输入阻抗高、驱动功耗小安全工作区宽、温度稳定性好等优点。该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大功能。

器件采用 A3-02B 型金属封装, 静电放电敏感度为 500V, A3-02B 典型重量 1.13g。



2、质量等级及执行标准

G、G+:Q/RBJ1005QZ, QJZ840611;

JCT/K, JCT/K+ (A3-02B): Q/RBJ22032H1-2016, GJB33A-1997;

3、最大额定值

器件额定值见表 1, 除另有规定外, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	P_D^a $T_C=25^{\circ}\text{C}$ W	V_{GS} V	I_{DM1} $T_C=25^{\circ}\text{C}$ A	I_{DM2} $T_C=100^{\circ}\text{C}$ A	T_{JM} $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	$R_{(th)J-A}$ $^{\circ}\text{C/W}$
LYNM210G	15	± 20	2.25	1.5	150	-55~150	180
^a $T_C > 25^{\circ}\text{C}$ 时, 按 0.12W/ $^{\circ}\text{C}$ 线性降额。							

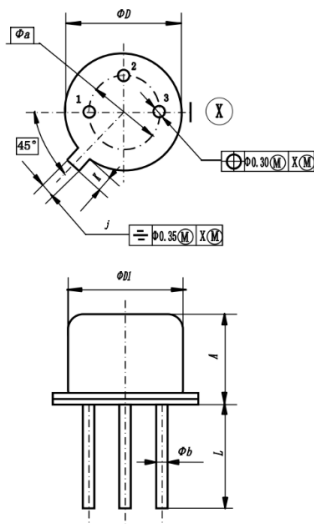
4、主要电特性

主要电特性 (除另有规定外, $T_A=25^{\circ}\text{C}$) 见表 2。

表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=I_{DM2}$	—	—	1.5	Ω
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=1.0mA$	200	—	—	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=0.25mA$	2.0	—	4.0	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}, V_{GS}=0V$	—	—	25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20V$	—	—	-100	nA
开启延迟时间	$t_{d(ON)}$	$V_{DD}=100V, V_{GS}=10V, I_D=1.5A, R_G=7.5\Omega$	—	45	—	ns
上升时间	t_r		—	75	—	ns
关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	75	—	ns
下降时间	t_f		—	60	—	ns
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=100V, I_D=5.5A, V_{GS}=10V$	—	42.1	—	pF

5、外形尺寸



单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典 型 值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φa	—	5.08	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.612	0.787	0.963
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1-源极 2-栅极 3-漏极

A3-02B 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。